

Fourier Transform Method: Application to Inhomogeneous Dielectric Gratings

Tsuneki YAMASAKI

In this report, Fourier Transform method, which is numerical analysis in the frequency domain, has been applied to the analysis of the scattering and guiding problems by inhomogeneous dielectric gratings using the combination of the multilayer division method. We also applied to the multilayered circular dielectric gratings such as photonic bandgap crystals. Numerical results are given for the transmission coefficients and propagation constants by varying the cross section of the rectangular profiles comparing with both TM and TE waves, and are also given for the rectangular dielectric constants of photonic bandgap crystals by varying the cross section of the rectangular dielectric constants comparing with both TM and TE modes.

Key words: Fourier Transform, scattering and guiding problems, inhomogeneous dielectric gratings, multilayered circular dielectric gratings, photonic bandgap crystals

近年,種々の光集積回路デバイス(光グレーティング, 光結合器,光導波路フィルター,ファイバーグレーティン グ)の設計において,実験によるデバイスの設計だけでは 対応できなくなり,コンピューターシミュレーションの結 果をもとに,デバイスの設計,実験の補間,実験結果の確 認など,コンピューターシミュレーションが不可欠となっ てきている¹⁾.このようなシミュレーション技術において は,計算電磁気学の役割が不可欠で²⁾,適用範囲が広く誤 差評価や誤差制御が容易なコンピューターシミュレーショ ン技術が望まれてきた.

最近,フォトニック結晶構造の光導波路の研究が注目を 集めている²⁾.フォトニック結晶光導波路(以下 PCOW とよぶ)は,波長程度の光を強く閉じ込めることができる ため,周期構造に欠陥を設けることにより光を任意方向に 曲げることが可能となる.これによって,新しいナノテク ノロジー領域での光デバイスとして期待が高まってい る³⁾.しかし,ナノテクノロジーでは,光の波長と同程度 となり設計が困難となるため,コンピューターシミュレー ション技術により特性の把握が必要になってくる.現在, コンピューターの向上により,時間領域差分法 (FDTD 法)⁴⁾や有限要素時間領域ビーム伝搬法 (FETD-BPM)⁵⁾ など種々の解析手法が提案されているが⁶⁻¹⁰,周期構造で 欠陥を設ける場合に重要となるストップバンド領域での伝 搬特性(特に減衰特性)については,詳細な解析例は示さ れていない.

ここでは、まず、周期構造媒体内のフーリエ変換法によ る電磁界解析法について述べ、応用例として、不均質誘電 体グレーティングの散乱・伝搬問題、さらにフォトニック 結晶導波路問題について解析した結果を紹介する。筆者ら のフーリエ変換法は、多層分割法と併用することにより、 解くべき連立方程式の次元数が電磁界の打ち切りモード数 となり層内の分割層数とならない点で、多層構造を有する フォトニック構造導波路問題には特に有効な解法である。 本解析法は、誤差評価や誤差制御が容易で、既存の計算機 ライブラリーで計算でき(行列問題、固有値問題など)、 しかも散乱問題や伝搬問題が同じアルゴリズムで精度よく 解析できる点で、コンピューターシミュレーションに適し た解法である。

日本大学理工学部電気工学科(〒101-8308 東京都千代田区神田駿河台 1-8-14) E-mail: yamasaki@ele.cst.nihon-u.ac.jp



1. 周期構造媒体内の電磁界解析法

電磁波が広い分野で利用されるに伴い,不均質媒質との 相互作用が重要な問題となっている。特に,誘電率や誘電 体形状が1つの空間座標の周期関数であるような周期構造 媒体の電磁界解析においては,波長と同程度のデバイスを 設計する必要があるので,入射波の偏波方向まで考慮して 高精度に解析できる解法がいろいろと検討されてきた。有 力な解法のひとつである空間高調波展開法¹¹⁾は,誘電率 分布に不連続点をもつ場合には解析できない難点があっ た.

本報告では、周期構造媒体の電磁界解析法として、波 動・信号工学で有用なフーリエ変換(通常は時間から周波 数への変換($t \rightarrow \omega$)であるが、ここでは空間から空間周 波数への変換($x \rightarrow n$)である)を紹介し、この解法が従 来法の問題点を解決する解法であることを、図1のx方 向に周期的に誘電率が不均質となる場合について要点を示 す.

不均質媒質層はy方向に一様とし、電磁波の入射偏波 は、TM iz^{12} (磁界がz成分のみ)とし、透磁率 μ は真 空の透磁率 μ_0 とする。時間因子は $e^{j\omega t}$ として、以下省略 する。

y 方向の伝搬定数をh (未知)とすると,z方向の磁界 H_z は, $H_z riangle H(x) \cdot e^{ihy}$ となり,H(x)を満足する微分方 程式は次式となる¹².

$$\frac{\mathrm{d}^{2}H(x)}{\mathrm{d}x^{2}} - \frac{1}{\varepsilon(x)} \frac{\mathrm{d}\varepsilon(x)}{\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}H(x)}{\mathrm{d}x} + [k^{2}(x) - h^{2}]H(x) = 0$$

$$k(x) \triangleq \omega\sqrt{\varepsilon(x)} \mu_{0} = k_{0}^{2}\varepsilon(x)/\varepsilon_{0}, \quad k_{0} \triangleq \omega\sqrt{\varepsilon_{0}\mu_{0}} = 2\pi/\lambda_{0}$$

$$(1)$$

ただし, ε_0 , μ_0 , λ_0 は, それぞれ自由空間の誘電率, 透磁率, 波長である.

フロケの定理⁵⁾を用いて H(x) をフーリエ展開

$$H(x) = e^{-jg_0 x} \sum_{n=-N}^{N} u_n e^{j2\pi n x/p}; \ p = \exists \exists \exists$$
(2)

する.ただし、N は電磁界の打ち切りモード数、 g_0 は、 境界条件で決まる x 方向の伝搬定数である. $\varepsilon(x)$ を次式 のように分解しておく.

$$\varepsilon(x)/\varepsilon_0 \triangleq f(x)/g(x)$$
 (3)

式(3)は一見強い制限のように思われるが、工学的に重要な分布はほとんどが式(3)のように近似できる(逆二 乗分布 [=1+1/{1+(x/p)²}]や sech 分布 [=sech(x/p)]). 式(2),(3)を式(1)に代入し、フーリエ変換(f(x) $g(x)e^{-j2\pi mx/p}$ を掛けて1周期にわたって積分)すると、 h^2 についての固有値方程式が得られる¹²).

$$\Lambda_1 \mathbf{U} = h^2 \Lambda_2 \mathbf{U} \tag{4}$$

ただし,

$$\begin{split} \Lambda_{1} &\triangleq [\eta_{m,n}], \quad \Lambda_{2} &\triangleq [\zeta_{m,n}], \quad \mathbf{U} \triangleq [u_{-N}, \cdots, u_{0}, \cdots, u_{N}]^{T} \\ \zeta_{n,m} &\triangleq k_{0}^{2} \xi_{n,m} - \gamma_{n} \{\gamma_{n} \eta_{n,m} + 2\pi (n-m) \eta_{n,m} / p - \varphi_{n,m} \} \\ \eta_{n,m} &\triangleq \frac{1}{p} \int_{0}^{p} \{f(x) g(x) \} e^{j2\pi (n-m)x/p} \mathrm{d}x \\ \varphi_{n,m} &\triangleq \frac{2j}{p} \int_{0}^{p} \{f(x) \frac{\mathrm{d}g(x)}{\mathrm{d}x} \} e^{j2\pi (n-m)x/p} \mathrm{d}x \\ \xi_{n,m} &\triangleq \frac{1}{p} \int_{0}^{p} \{f(x) \}^{2} e^{j2\pi (n-m)x/p} \mathrm{d}x \\ \gamma_{n} &\triangleq (g_{0} + 2\pi n/p), \quad m, \quad n = (-N, \cdots, 0, \cdots, N) \end{split}$$

式(5)の展開係数 $\eta_{n,m}$, $\varphi_{n,m}$, $\xi_{n,m}$ は解析的に求められ る場合が多いので,適用範囲が広い.しかしながら,誘電 率分布が不連続点を含む場合(例えば,ステップ分布)に は,式(5)の $\eta_{n,m}$ が,O(1/|n-m|)となり, $n, m \to \infty$ で $\xi_{n,m} \to 0(n \neq m)$ とならない.この難点を解決するため, 式(3)のf(x)(あるいはg(x))を

(x) or
$$g(x) = \sum_{n=-N_f}^{N_f} \tau_n e^{j2\pi nx/p}$$
 (6)

と N_f 項までのフーリエ級数で近似し, $N \in N = \alpha N_f(\alpha \gg$ 1)と関係づける.数値実験から, $N \ge 1.5 N_f^{12}$ とすれば精 度よく求められるので,本解法は、 η_{nm} , φ_{nm} , ξ_{nm} が収束 級数であれば適用できる.なお、不連続点を含む誘電率を フーリエ展開するとギブズ現象¹²⁾を生じるが、式(6)で 十分大きなNを用いればギブズ現象の問題点を解決でき る¹².

2. 不均質誘電体グレーティングへの応用

f

応用例として,図2(a)の不均質誘電体グレーティング の散乱・伝搬問題の解析例を紹介する.誘電体グレーティ ングは,光結合器,周波数選択フィルター,多層膜回折格



図2 不均質誘電体グレーティング.(a)構造と座標系,(b) 不均質領域の多層分割.

子の設計等に重要なため、種々の解析法が提案され数値結 果も報告されている。グレーティング形状が任意でグレー ティング内の媒質が不均質の場合、グレーティング層を多 層に分割し(分割数M;図2(b))すれば、薄層内での誘 電率 $\epsilon(x, y)$ は、x成分のみの分布 $\epsilon(x)$ で近似できるの で、1章で求めた電磁界が利用できる。Moharamらは¹³、 多層分割法と改良モード結合理論を併用して、レリーフ型 や傾斜型グレーティングの散乱問題を解析しているが、解 くべき連立一次方程式の次元数が層数とともに増加するの で、散乱問題しか取り扱っていない。

本解法は、多層分割法とフーリエ変換法を併用して解析 しているが¹⁴⁻¹⁷,解くべき連立一次方程式の次元数は分 割層数によらず電磁界の打ち切りモード数となるため、散 乱問題のみならず伝搬問題(特に傾斜型グレーティン グ¹⁸⁾)にはきわめて有効である。

2.1 散乱問題の解析法

TM 波が x>0 から入射角 θ₀ で入射する散乱問題¹⁵⁾ に ついて要点を述べる. TE 波については数値結果のみ示 す.各領域の電磁界は次式となる.

$$S_1(x \ge 0): H_z^{(1)} = e^{-jk_1(x\sin\theta_0 - y\cos\theta_0)} + e^{-jk_1x\sin\theta_0}$$

$$\sum_{n=-N}^{N} r_n^{(1)} e^{-j(k_n^{(1)}y + 2\pi nx/p)}$$
(7)

 $S_3(x \le -d): H_z^{(3)} = e^{-jk_1x\sin\theta_0}$

$$\sum_{k=-N}^{N} t_{n}^{(3)} e^{j\{k_{n}^{(3)}(y+d)-2\pi nx/p\}}$$
(8)

$$E_x^{(i)} = (\partial H_z^{(i)} / \partial y) / (j\omega\varepsilon_i)$$

$$k_n^{(i)} \triangleq \sqrt{k_0^2 \varepsilon_i / \varepsilon_0 - (g_0 + 2\pi n/p)^2}, \quad g_0 \triangleq k_1 \sin \theta_0,$$

$$k_1 \triangleq \omega \sqrt{\varepsilon \mu}, \quad i = 1, 3$$

$$\underline{S_2(-d < x < 0)}: \qquad (9)$$

$$H_{z}^{(2,l)} = \sum_{\nu=1}^{2N+1} \left[A_{\nu}^{(l)} e^{jh_{\nu}^{(l)}\{y+(l-1)d_{d}\}} + B_{\nu}^{(l)} e^{-jh_{\nu}^{(l)}(y+ld_{d})} \right] \cdot f_{\nu}^{(l)}(x)$$
(10)

$$E_{x}^{(2,l)} = (\partial H_{z}^{(2,l)} / \partial y) / \{j\omega\varepsilon^{(l)}(x)\}$$

$$f_{\nu}^{(l)}(x) \triangleq e^{-jk_{1}x\sin\theta_{0}} \sum_{n=-N}^{N} u_{\nu,n}^{(l)} e^{j2\pi nx/p},$$

$$d_{d} = d/M, \ i = 1 \sim M$$
(11)

ただし、 $r_n^{(1)}$, $t_n^{(3)}$, $A_{\nu}^{(l)}$, $B_{\nu}^{(l)}$ は、境界条件から決まる反射係数および透過係数である。y=0, $y=-l \cdot d_{\mathcal{A}}(l=1\sim M-1)$, y=-dの境界条件式

$$y = 0: [H_z^{(1)} = H_z^{(2,1)}]; [E_x^{(1)} = E_x^{(2,1)}]$$
(12)

$$y = -l \cdot d_d (l = 1 \sim M - 1): [H_z^{(2,l)} = H_z^{(2,l+1)}];$$
(13)

$$y = -d: [H_z^{(2,M)} = H_z^{(3)}]; [E_x^{(2,M)} = E_x^{(3)}]$$
(14)

において,式(7)~(11)を式(12)~(14)に代入し, {*e*^{*i*2π*n*z/*p*}の直交性を利用して,1層目の係数**A**⁽¹⁾,**B**⁽¹⁾と *M*層目の係数**A**^(M),**B**^(M)の関係についてまとめると,次式 となる.}

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A}^{(l)} \\ \mathbf{B}^{(l)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{S}_{1}^{(1)} & \mathbf{S}_{2}^{(1)} \\ \mathbf{S}_{3}^{(1)} & \mathbf{S}_{4}^{(1)} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{S}_{1}^{(2)} & \mathbf{S}_{2}^{(2)} \\ \mathbf{S}_{3}^{(2)} & \mathbf{S}_{4}^{(2)} \end{pmatrix} \cdots \\ \begin{pmatrix} \mathbf{S}_{1}^{(M)} & \mathbf{S}_{2}^{(M)} \\ \mathbf{S}_{3}^{(M)} & \mathbf{S}_{4}^{(M)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A}^{(M)} \\ \mathbf{B}^{(M)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{S}_{1} & \mathbf{S}_{2} \\ \mathbf{S}_{3} & \mathbf{S}_{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A}^{(M)} \\ \mathbf{B}^{(M)} \end{pmatrix}$$
(15)

ただし,

$$\begin{split} \mathbf{S}_{k}^{(l)} &\triangleq \begin{bmatrix} (l) & \mathbf{S}_{n,\nu}^{(l)} \end{bmatrix}, \ (l) & \mathbf{S}_{n,\nu}^{(l)} \triangleq \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \mathbf{v}_{n,\nu}^{(l)} + \theta_{n,\nu}^{(l)} & h_{n+N+1}^{(l+1)} / h_{\nu}^{(l)} \end{bmatrix} e^{-jh_{\nu}^{(l)} d_{d}} \\ & \overset{(l) & \mathbf{S}_{n,\nu}^{(2)} \triangleq \overset{(l) & \mathbf{S}_{n,\nu}^{(3)} \cdot \mathbf{e}^{i(h\# \ddagger 1) - h^{(l)} d_{d,(l)} \mathbf{S}_{n,\nu}^{(3)}} \\ & \triangleq \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \mathbf{v}_{n,\nu}^{(l)} - \theta_{n,\nu}^{(l)} & h_{n+N+1}^{(l+1)} / h_{\nu}^{(l)} \end{bmatrix} \\ & \overset{(l) & \mathbf{S}_{n,\nu}^{(4)} \triangleq \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \mathbf{v}_{n,\nu}^{(l)} + \theta_{n,\nu}^{(l)} & h_{n+N+1}^{(l+1)} / h_{\nu}^{(l)} \end{bmatrix} e^{jh_{n+N+1}^{(l)} d_{d}}; \\ & k = 1 \sim 4, \ l = 1 \sim M \\ \mathbf{V} \triangleq \begin{bmatrix} v_{n,\nu}^{(l)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{U}^{(l)} \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{U}^{(l+1)} \end{bmatrix}, \ \mathbf{U}^{(l)} \triangleq \begin{bmatrix} u_{n,\nu}^{(l)} \end{bmatrix}, \\ & \Theta \triangleq \begin{bmatrix} \theta_{n,\nu}^{(l)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Phi^{(l)} \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \Psi^{(l+1)} \end{bmatrix} \\ & \Theta^{(l)} \triangleq \begin{bmatrix} \phi_{n,\nu}^{(l)} \end{bmatrix}, \ \Psi^{(l)} \triangleq \begin{bmatrix} \phi_{n,\nu}^{(l)} \end{bmatrix}, \ \phi_{n,\nu}^{(l)} \triangleq \sum_{m=-N}^{N} u_{\nu,m}^{(l)} \chi_{m,n}^{(l+1,l)}, \\ & \psi_{n,\nu}^{(l+1)} \triangleq \sum_{m=-N}^{N} u_{\nu,m}^{(l+1)} \chi_{m,n}^{(l,l+1)}, \\ & \chi_{m,n}^{(s,q)} \triangleq \frac{1}{p} \int_{0}^{p} \{f^{(s)}(x) g^{(q)}(x)\} e^{j2\pi(m-n)x/p} dx \\ & \zeta (15) \ O \ B \ (\mathbf{K} \ \mathbf{X} \ \mathbf{K} \ \mathbf{H} \ \mathbf{V} \mathbf{X} \ \mathbf{K} \ \mathbf$$

式 (15)の関係式を用いて, *M* 層目の透過係数 *A*^(M)(*v*= 1~ *N*) について整理すると, (2*N*+1) 次元の方程式が得られる^{19,20}.

式(16)の連立一次方程式は、既存のライブラリー(LU 分解)で計算でき、分割層数が増加しても、次元数は打ち 切りモード数としているので伝搬問題は特に有効である。

n次空間高調波の電力透過係数 $|T_n^{(TM)}|^2$ は、次式で求められる。

$$|T_n^{(TM)}|^2 \triangleq \varepsilon_1 \operatorname{Re}\{k_n^{(3)}\} |t_n^{(3)}|^2 / (\varepsilon_3 k_1^{(1)})$$
 (17)

2.2 伝搬問題の解析法

伝搬問題¹⁴⁾ については、散乱問題と同様な手順で解析 できるので要点を示す. x 方向の伝搬定数を $\gamma (\triangleq \beta - i\alpha; \alpha < 0)$ とすると、領域 S_1 、 S_3 の磁界は、次式で近似展開 できる.

$$H_{z}^{(1)} = e^{-j\gamma x} \sum_{n=-N}^{N} r_{n}^{(1)} e^{-j(k_{n}^{(1)}y + 2\pi nx/p)}$$
(18)

$$H_{z}^{(3)} = e^{-j\gamma x} \sum_{n=-N}^{N} t_{n}^{(3)} e^{-j\{k_{n}^{(3)}(y+d)-2\pi nx/\beta\}}$$
(19)

ただし, $k_n^{(i)} \triangleq \sqrt{k_0^2 \varepsilon_i / \varepsilon_0 - (\gamma + 2\pi n/p)^2}$, (i=1,3) である. $r_n^{(1)}$, $t_n^{(3)}$ は, 未定係数で境界条件より求められる. 伝搬問



題の場合, $k_n^{(i)}$ の符号は通常の放射条件 [Re($k_n^{(j)}$) ≥0, Im ($k_n^{(j)}$) ≤0] で,n < 0 で ($\beta + 2\pi n/p$) >0 の速波領域では Im($k_n^{(j)}$) ≥0 となる点が散乱問題の場合と異なる. 伝搬問 題では,散乱問題の式 (16) で **F**=0 に相当するので,散 乱問題での $k_1 \sin \theta_0$ を伝搬問題では $\gamma (\triangleq \beta - i\alpha)$ に置き 換えればよい. 散乱問題と同様に,M 層目の透過係数 $A_{L^{(M)}}(\nu = 1 \sim N)$ についての方程式は

$$\mathbf{W} \cdot \mathbf{A}^{(M)} = 0 \tag{20}$$

となる.式 (20) から,**A**^(M) がゼロでない解をもつために は、次式の特性方程式が得られる。

$$\det|\mathbf{W}| = 0 \tag{21}$$

伝搬定数 $\gamma (\triangleq \beta - i\alpha)$ は、式(4)の固有値方程式と式 (21)の特性方程式を同時に満足するように決定する。

2.3 数值解析例

グレーティング形状 s(z) は図1のように三角形状

$$s(x) \triangleq \begin{cases} -x/w & ; \ 0 \le x < w \\ -(p-x)/(p-w) & ; \ w \le x < p \end{cases}$$
(22)

で w/p をパラメーターとした.レリーフ内の誘電率分布 は、厚さ方向に正弦波状

$$\varepsilon(x, z) \triangleq \begin{cases} \varepsilon_1 & ; \ s(x) \le y < 0 \\ \varepsilon_A \left[1 + \delta \cos\left\{\frac{\pi}{d}(y)\right\} \right] & ; \ -d \le y < s(x) \end{cases}$$
(23)

とした.構造パラメーターは、d/p=2/3、 $\epsilon_1/\epsilon_0=\epsilon_3/\epsilon_0=1$ 、 $\epsilon_2/\epsilon_0=3(\epsilon_A/\epsilon_0=2)$ 、 $\delta=0.5$)とした. 伝搬問題の γ は、ミュラー法¹⁴⁾で計算(γ の値が7桁目で変化しない刻み幅)し、基本となる最低次のモード(TM₀, TE₀)について検討した.

はじめに収束について考察する.図3は,TM 波の散 乱問題の場合で、 $\theta_0=45^\circ$ 、w/p=0.5、 $p/\lambda=0.6$ 、N=9, $N_f=6$ ($\alpha=1.5$) としたときの $|T(T^M)|^2$ の収束である.図4 は、伝搬問題 (TM₀モード) で $p/\lambda=1$ 、w/p=0.5のと





図 5 散乱特性と伝搬特性 (TM 波). (a) 電力透過係数 $|T_0^{(TM)}|^2$, (b) 規格化位相定数 $\beta p/(2\pi)$, (c) 規格化減衰定数 $\alpha p/(2\pi)$.

きの 1/M に対する規格化伝搬定数 $\beta p/2\pi$ の収束である. いずれの図からも、 $M \gg 20$ とすれば真値との相対誤差を 1%以下にできる。数値解析においては、TM 波の場合 M=30、TE 波の場合 N=10、M=20 として計算した。 また、エネルギー誤差は、TM 波および TE 波とも 10^{-3} 以下であった。

図 5 (a),図 6 (a),は $w/p \ge 0 \sim 0.5 \ge \infty$ 化したときの p/λ に対する透過特性である。それぞれ TM 波と TE 波 に対応している。図 5 (b), (c),図 6 (b), (c) はそれぞ れ、伝搬問題の規格化伝搬定数 $\beta p/2\pi$ と規格化位相定数 $\alpha p/2\pi$ である。図中には均質媒質 ($\delta = 0$)の場合も示し た。図 5,図 6 から、次のことがわかる。

- 形状 (w/p) の影響は, TM 波で p/λ ≃0.6 と p/λ>
 1 で現れ, TE 波では p/λ>0.8 で現れる. これは, *α*p/2π が不均質媒質と均質媒質で違いが大きく現れ てくるところである.
- (2) 均質媒質の βp/2π は不均質媒質より大きい. これ



 $\rightarrow \alpha p/(2\pi)$

図6 散乱特性と伝搬特性 (TE 波). (a) 電力透過係数 $|T_0^{(TE)|^2}$, (b) 規格化位相定数 $\beta p/(2\pi)$, (c) 規格化減衰定数 $\alpha p/(2\pi)$.

は、均質媒質ではレリーフ内の誘電率の平均が、不均 質媒質のより小さくなるためである。

(3) p/λ>0.6 では, αp/2π は不均質媒質のほうが均質
 媒質より大きくなるが,特性の傾向は変わらない。

3. フォトニック結晶導波路への応用

フォトニック結晶導波路の解析では、多層の円柱誘電体 構造となる。ここでは、多層で柱状構造とし柱状内の誘電 率分布は不均質構造の場合の適用法について要点を示し、 円柱間に十字型方形誘電体(横長軸: c₁,横短軸: c₂)を 装荷した誘電体構造が伝搬特性に及ぼす影響を検討した結 果を紹介する¹⁹⁻²¹⁾。また、円柱内を不均質とした場合の 伝搬特性の影響についても考察した。

グレーティング領域 S_2 内 (-D < x < 0) は,厚さ d 間隔で n 個の不均質柱状誘電体 $\varepsilon_2(x, z)$ で構成されている (D=nd) とする (図7(a) は (n=4) の場合である).2





図7 方形誘電体を装荷した多層柱状誘導体グレーティング. (a)構造と座標系,(b)不均質領域の多層分割.

段目以降 $(n \ge 2)$ は、1段目と同一構造である (図7 (b)). x = -d での境界条件より、1段目最後の層の $\mathbf{A}^{(M)}$, $\mathbf{B}^{(M)}$

と2段目第1層のA⁽¹⁾,B⁽¹⁾との関係式は,

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A}^{(M)} \\ \mathbf{B}^{(M)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{S}_{1}^{(M+1)} & \mathbf{S}_{2}^{(M+1)} \\ \mathbf{S}_{3}^{(M+1)} & \mathbf{S}_{4}^{(M+1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A}^{(1)} \\ \mathbf{B}^{(1)} \end{pmatrix}$$
(24)

となる.2段目の第1層目の**A**⁽¹⁾,**B**⁽¹⁾と2段目の最終層 **A**^(2M),**B**^(2M)との関係式は,

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A}^{(1)} \\ \mathbf{B}^{(1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{S}_{1}^{(M+1)} & \mathbf{S}_{2}^{(M+1)} \\ \mathbf{S}_{3}^{(M+1)} & \mathbf{S}_{4}^{(M+1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{S}_{1} & \mathbf{S}_{2} \\ \mathbf{S}_{3} & \mathbf{S}_{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A}^{(2M)} \\ \mathbf{B}^{(2M)} \end{pmatrix}$$
(25)

と表せる.3段目以降 $(n \geq 3)$ も同様に解析でき、一般に 1段目の $\mathbf{A}^{(1)}$, $\mathbf{B}^{(1)} \geq n$ 段目 $\mathbf{A}^{(nM)}$, $\mathbf{B}^{(nM)}$ との関係式は、

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A}^{(1)} \\ \mathbf{B}^{(1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{S}_1 & \mathbf{S}_2 \\ \mathbf{S}_3 & \mathbf{S}_4 \end{pmatrix} [\mathbf{F}]^{n-1} \begin{pmatrix} \mathbf{A}^{(nM)} \\ \mathbf{B}^{(nM)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{S}'_1 & \mathbf{S}'_2 \\ \mathbf{S}'_3 & \mathbf{S}'_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A}^{(nM)} \\ \mathbf{B}^{(nM)} \end{pmatrix}$$

$$(26)$$

となり、1段目の $\mathbf{S}_1 \sim \mathbf{S}_4$ と1段目と2段目を接続する $\mathbf{S}^{(M+1)}$ のみを用いて関係づけられる.ただし

$$[\mathbf{F}]^{n-1} \triangleq \left[\begin{pmatrix} \mathbf{S}_{1}^{(M+1)} & \mathbf{S}_{2}^{(M+1)} \\ \mathbf{S}_{3}^{(M+1)} & \mathbf{S}_{4}^{(M+1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{S}_{1} & \mathbf{S}_{2} \\ \mathbf{S}_{3} & \mathbf{S}_{4} \end{pmatrix} \right]^{n-1}$$
(27)

式 (27) の計算には、行列 **F** の固有値 $\lambda = \{\lambda_1, \dots, \lambda_{2(2n+1)}\}$ と固有ベクトル $\mathbf{u}^{(\lambda)} = \{u_1^{(\lambda)}, \dots, u_{2(2n+1)}^{(\lambda)}\}$ を用いて、次式か ら計算する.

$$[\mathbf{F}]^{n-1} = [\mathbf{u}^{(\lambda)}] \begin{bmatrix} \boldsymbol{\lambda}_1^{n-1} & 0\\ 0 & \boldsymbol{\lambda}_{2(2n+1)}^{n-1} \end{bmatrix} [\mathbf{u}^{(\lambda)}]^{-1}$$
(28)

式 (26) を式 (15) の関係式に対応させれば, 伝搬問題の特 性方程式が得られる.

3.1 数值解析

検討した不均質柱状誘電体(-d<y<0)の形状は,柱 状形状

$$[(y+d/2)/(d/2)]^{2}+(x/a)^{2}=1$$
 (29)

とし、その誘電率分布 $\varepsilon_2(x, z)$ は、径 $(r riangleq \sqrt{x^2 + y^2})$ 方向に二乗分布

$$\varepsilon_{2}(x, z) \triangleq \begin{cases} \varepsilon_{2} [1 - b\{(2(y + d/2)/d)^{2} + (x/a)^{2}\}];\\ b = 1 - \varepsilon_{1}/\varepsilon_{2} : 柱状誘電体内\\ \varepsilon_{3} : +字型誘電体内\\ \varepsilon_{1} : 柱状誘電体間 \end{cases}$$

(30)

とし、グレーティングの媒質と構造パラメーターは、 $\epsilon_1/\epsilon_0=1, \epsilon_2/\epsilon_0=3, D/p=2/3, d/p=1/6$ とした.

図 8 は、TM₀ mode において縦比 b/d=1/2、 $c_1/p=1/4$ を一定とし、柱状誘電体の誘電率分布を均質円筒 ($\varepsilon_2/\varepsilon_0$ =3.0)として十字型方形誘電体の横比 ($=c_2/c_1$)を変化した場合における伝搬特性である。図 9 は、TE₀ mode の場合である。TM₀ mode および TE₀ mode ともに、 $c_2/c_1=0$ を実線、 $c_2/c_1=0.25$ を一点鎖線、 $c_2/c_1=0.5$ を破線、 $c_2/c_1=$ 0.75を二点鎖線、 $c_2/c_1=1.0$ を点線で示した。図 8 と図 9より次のことがわかる。



図8 p/λ に対する伝搬定数 $\gamma(=\beta+j\alpha)$; TM₀ mode. (a) 規格化位相定数 $\beta p/(2\pi)$, (b) 規格化減衰定数 $\alpha p/(2\pi)$.



図 9 p/λ に対する伝搬定数 $\gamma(=\beta+j\alpha)$; TE₀ mode. (a) 規格化位相定数 $\beta p/(2\pi)$, (b) 規格化減衰定数 $\alpha p/(2\pi)$.



図 10 p/λ に対する伝搬定数 $\gamma(=\beta+j\alpha)$; TE₀ mode. (a) 規格化位相定数 $\beta p/(2\pi)$, (b) 規格化減衰定数 $\alpha p/(2\pi)$.



図 11 p/λ に対する伝搬定数 $\gamma(=\beta+j\alpha)$; TE₀ mode. (a) 規格化位相定数 $\beta p/(2\pi)$, (b) 規格化減衰定数 $\alpha p/(2\pi)$.

- TM₀ mode の場合, c₂/c₁ を大きくすると1周期内 の等価誘電率が大きくなるため, Stop band 領域での 遮断幅 (βp/(2π)=0.5) は p/λ の低いほうに移動し, その最大減衰量は大きくなる.
- (2) TE₀ mode の場合, Stop band 領域での最大減衰量 と遮断幅は TM₀ mode に比べて大きくなり, TM₀ mode に比べて Stop band 領域の周波数の高いところ (上部) でほぼ一致している.

図 10 は、図 8 で $c_2/c_1 = 1/4$ の場合において、十字型方 形誘電体の縦比(=b/d)を変化した場合の伝搬特性であ る、図 11 は TE₀ mode の場合である、図 10 と図 11 から、 十字型方形誘電体の縦比を変化すると、Stop band 領域は 規格化周波数 (= p/λ)の低いほうに移動し、最大減衰量 と遮断幅も比例して変化することがみてとれる.

図8と図9の条件で, $c_2/c_1=1/2$ としたときの不均質円 筒 ($\varepsilon_2/\varepsilon_0=1\sim3$)と均質円筒 ($\varepsilon_2/\varepsilon_0=3$)の伝搬特性を 比較したのが図12と図13である。図12,13から次のこ とがわかる。

(1) Stop band 領域での遮断幅と減衰量は,不均質分布 の場合のほうが均質分布の場合と比べて大きい.これ は,不均質円筒の等価誘電率が均質円筒の場合に比べ て低いからである.



図 12 $c_2/c_1=1/2$ における均質円筒と不均質円筒の伝搬定数の比較;TM₀ mode. (a) 規格化位相定数 $\beta p/(2\pi)$, (b) 規格化減衰定数 $\alpha p/(2\pi)$.



図 13 $c_2/c_1=1/2$ における均質円筒と不均質円筒の伝搬定数の比較; TE₀ mode. (a) 規格化位相定数 $\beta p/(2\pi)$, (b) 規格化減衰定数 $\alpha p/(2\pi)$.

(2) 分布の影響は、遮断幅の上部から現れる。

本報告ではフーリエ変換法の電磁界解析法について述 べ,応用例として不均質誘電体グレーティングの散乱・伝 搬問題,さらにフォトニック結晶導波路問題について解析 した結果を紹介した.フーリエ変換法を適用する場合の利 点は,

- 1) 散乱・導波問題が同一アルゴリズムで高精度に解析 でき、しかも誤差制御が容易である
- 2) 媒質の形状や誘電率分布が任意に適用できる
- ストップバンド領域付近の伝搬特性(位相特性と滅 衰特性)が高精度に解析できる

ことである。これはナノ構造へのいろいろな形状に適用で きる点で有力な解法である。

文 献

- 小柴正則:"光集積回路の設計・シミュレーション",電子情報通信学会論文誌, J77-C-I (1994) 159-167.
- 2) 生野浩正:"計算電磁気学とは何か",電気学会論文誌,120-A (2000) 737-740.
- 特集「フォトニックナノ構造を中心とした光技術の最新話 題」、オプトロニクス、287 (2005) 109-149.

- A. Adibi, Y. Xu, R. K. Lee, A. Yariv and A. Scherer: "Properties of the slab modes in photonic crystal optical waveguides," J. Lightwave Technol., 18 (2000) 1554–1565.
- M. Koshiba, Y. Tsuji and M. Hikari: "Time-domain beam propagation method and its application to photonic crystal circuits," J. Lightwave Technol., 18 (2000) 102–110.
- K. Sakoda: "Transmittance and Bragg reflectivity of twodimensional photonic lattices," Phys. Rev. B, 52 (1995) 8992–9002.
- H. Ikuno, Y. Noka and A. Yata: "Analysis of optical waveguide devices using the FD-TD method based on the principles of multidimensional wave digital filters," Radio Sci., 35 (2000) 595-605.
- 8) 佐藤弘明,吉田則信,宮永喜一:"種々の媒質条件をもつ2 次元フォトニック結晶光導波路の凝縮節点空間回路網による 基本特性解析",電子情報通信学会論文誌 (C), J84-C (2001) 954-963.
- 9) 松本恵治,小松 実,山北次郎:"行列固有値法によるフォ トニック結晶構造光導波路の解析",第 33 回電気学会電磁界 理論シンポジウム,EMT-04-97 (2004) pp. 43-48.
- Y. Ohtera, Y. Sasaki and S. Kawakami: "Postprocessing of FDTD solutions for precise calculations of eigenfrequencies of photonic periodic structures utilizing the variational expression," J. Lightwave Technol., 22 (2004) 1628-1636.
- S. T. Peng, H. L. Bertoni and T. Tamir: "Theory of periodic dielectric waveguides," IEEE Trans. Microwave Theory Tech., MTT-23 (1975) 123–133.
- 山崎恒樹,日向隆,細野敏夫: "周期的誘電率分布を持つ平面格子の電磁界解析",電子情報通信学会論文誌,J68-B (1985) 125-132.

- M. G. Moharam and T. K. Gaylord: "Diffraction analysis of dielectric surface-relief gratings," J. Opt. Soc. Am., 72 (1982) 1385–1392.
- 14) T. Yamasaki, T. Hosono and J. A. Kong: "Propagation characteristics of dielectric waveguides with periodic surface-relief," IEICE Trans. Electron., E74 (1991) 2839– 2847.
- 15) T. Yamasaki, H. Tanaka, T. Hinata and T. Hosono: "Analysis of electromagnetic fields in inhomogeneous dielectric gratings with periodic surface relief," Radio Sci., 31 (1996) 1931-1939.
- 16) T. Yamasaki, T. Hinata and T. Hosono: "Scattering and guiding of electromagnetic waves in inhomogeneous dielectric gratings with periodic surface relief," Telecomm. Radio Eng., 54, No. 8-9 (2000) 14-27.
- 17) T. Yamasaki, T. Hinata and T. Hosono: "Short optical pulse switching in three-core nonlinear fiber couplers," 電気

学会論文誌 A, 122 (2002) 28-33.

- H. Tanaka, T. Yamasaki and T. Hosono: "Propagation characteristics of dielectric waveguides with slanted grating structure," IEICE Trans. Electron., E77-C (1994) 1820– 1827.
- 19) T. Yamasaki, T. Hinata and T. Hosono: "Scattering of electromagnetic waves by multilayered dielectric gratings with elliptically layered media," Telecomm. Radio Eng., 56 (2002) 100–108.
- 20) 山崎恒樹:"フーリエ変換法",計算電磁気学,電気学会編 (培風館, 2003) pp. 171-187.
- 21) 尾崎亮介,山崎恒樹,日向 隆:"方形誘電体を装荷した多層 柱状誘電体グレーティングの伝搬特性(その2)",第34回電 気学会電磁界理論シンポジウム,EMT-05-90 (2005) pp.41-46.

(2006年3月22日受理)